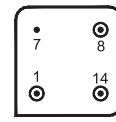
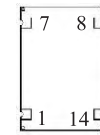


性能特点

- 低功耗~10mW
- 宽温度范围
- 外部频率微调
- 标准频率10MHz、20MHz



DIP8



M11

底视图

引脚功能

- 1: 微调端
- 7: 地
- 8: 信号输出端
- 14: 电源端

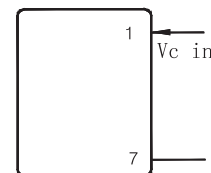
电性能表

参数名称		特性		
电源电压		+5V±5%, +3.3V±5%		
频率范围		8~40MHz		
频率 稳定度	VS. 温度	±0.5~±5ppm (见右表)		
	VS. 电源	±0.3ppm (Max) /Vdc±5%		
	VS. 老化	±1.5ppm/第一年 (Max)		
输出 特性	Sinewave	输出幅度	0dBm/50Ω, 可选+5dBm/50Ω	
		谐波失真	≤-20dB	
		杂波抑制	≤-70dB	
	Clipped Sinewave		0.8Vp-p (min) /10kΩ//10PF	
	HCMOS/ TTL	上升时间	≤6ns	15PF 负载
		下降时间	≤6ns	
占空比		40%~60%		
相位噪声 10MHz 典型值	100Hz	-110 dBc		
	1KHz	-135 dBc		
	100KHz	-145 dBc		
电源电流		1~15mA		
工作温度范围		多种温度范围 (见右表)		
储存温度范围		-55~+100℃		
可变频率范围		±3ppm (Min)		
尺寸		见M11/DIP8外形尺寸图		

频率温度稳定度 (ppm)

	±0.5	±1	±1.5	±2	±3	±5
0~50℃	GP	HP	IP	JP	KP	LP
-10~60℃	GR	HR	IR	JR	KR	LR
-20~70℃	GS	HS	IS	JS	KS	LS
-30~70℃	GQ	HQ	IQ	JQ	KQ	LQ
-40~70℃	GT	HT	IT	JT	KT	LT
-40~85℃	GU	HU	IU	JU	KU	LU

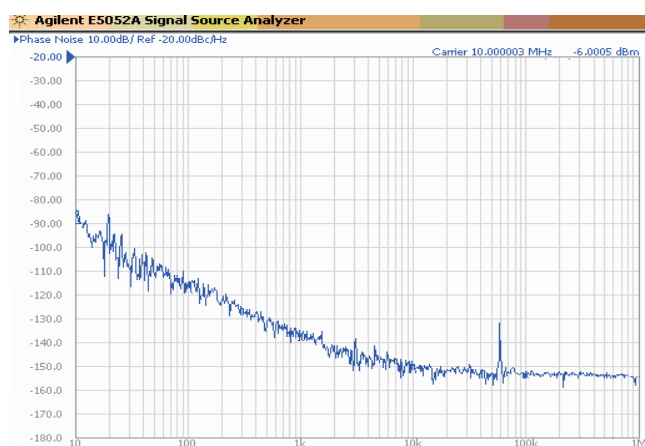
外部频率调节



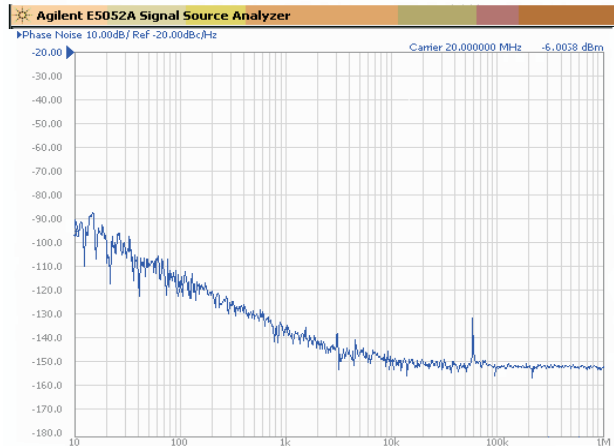
外接电压

极限参数

- 最高电源电压 --- +6V, +4V
- 最高储存温度 --- +105℃



相位噪声与频偏关系曲线@10MHz/3.3V



相位噪声与频偏关系曲线@20MHz/3.3V